

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 16 年 11 月 18 日 (2004.11.18)

【公開番号】特開 2003-158124 (P2003-158124A)

【公開日】平成 15 年 5 月 30 日 (2003.5.30)

【出願番号】特願 2001-353902 (P2001-353902)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/314

C 2 3 C 14/06

C 2 3 C 14/34

H 0 1 L 21/768

【F I】

H 0 1 L 21/314 A

C 2 3 C 14/06 F

C 2 3 C 14/34 N

H 0 1 L 21/90 K

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 11 月 26 日 (2003.11.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 5】

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、本発明によれば、化合物半導体、特に、水素と敏感に反応する化合物半導体上へ十分な付着強度、機械的硬度、絶縁性を有する絶縁膜および保護膜として炭素系薄膜を低温（室温～150 以下）で形成するものであり、化合物半導体デバイスを作製する際に留意しなければならない、基板の熱による変質（組成変化、表面粗さ）等のダメージを与えることがない。